

# 2Т709А - 2Т709В

аА0.339.144 ТУ

аналоги MJH11019  
MJH11017

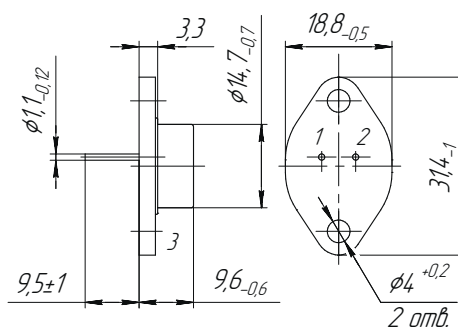


Мега - планарные составные транзисторы

Ключевые и линейные схемы аппаратуры специального назначения.  
T<sub>экспл</sub>: - 60°C ... +125°C



- 1 — база
- 2 — эмиттер
- 3 — коллектор



Металлостеклянный корпус КТ-8 (ТО-66)

№ п/п	Наименование параметра, единица измерения (режим измерения при T <sub>окр. ср.</sub> = +25°C)	Условное обозначение	Значение параметров					
			2Т709А		2Т709Б		2Т709В	
			не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более
1.	Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-база, В	U <sub>КБ max</sub>	100	-	80	-	60	-
2.	Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор – эмиттер, В (R <sub>БЭ</sub> ≤ 1 кОм)	U <sub>КЭ max</sub>	100	-	80	-	60	-
3.	Максимально допустимое постоянное напряжение эмиттер – база, В	U <sub>ЭБ max</sub>	5	-	5	-	5	-
4.	Максимально допустимый постоянный ток коллектора, А	I <sub>К max</sub>	-	10	-	10	-	10
5.	Статический коэффициент передачи тока, (U <sub>КБ</sub> = 5 В, I <sub>Э</sub> = 5 А)	h <sub>21Э</sub>	500	-	750	-	750	-
6.	Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В (I <sub>К</sub> = 5 А, при I <sub>Б</sub> = 0,02 А)	U <sub>КЭ нас</sub>	1,1	2	1,1	2	1,1	2
7.	Граничная частота коэффициента передачи тока, МГц	f <sub>гр</sub>	3	-	3	-	3	-
8.	Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора при T <sub>к</sub> = +25°C, Вт	P <sub>К max</sub>	-	30	-	30	-	30

Возможна поставка в бескорпусном исполнении разделенными или не разделенными на кристаллы

1. 1. 1. БИПОЛЯРНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ P-N-P ТИПА